

素子分離領域の歪解析

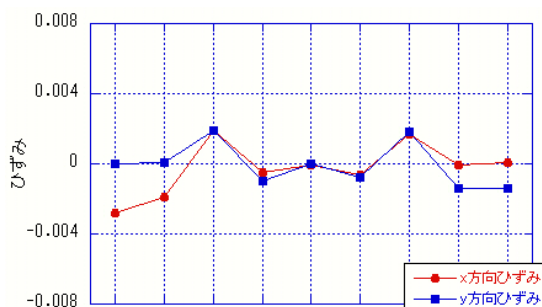
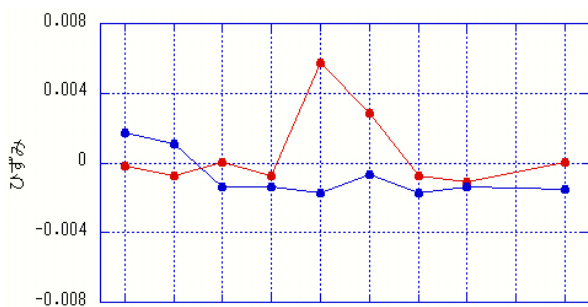
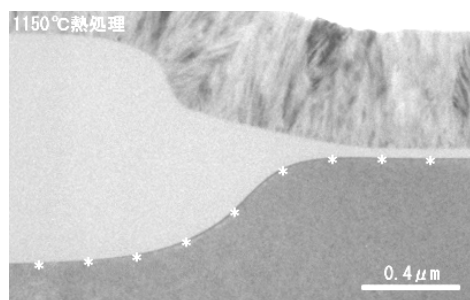
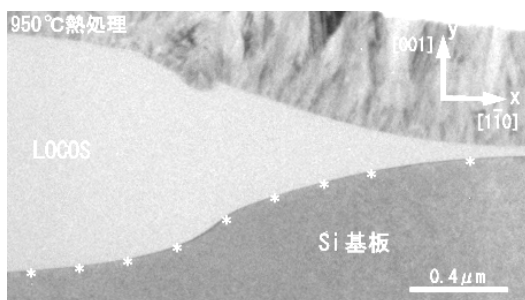
NBD: Nano Beam Diffractionによる微小領域の歪解析

測定法 : TEM
 製品分野 : LSI・メモリ
 分析目的 : 応力・歪み評価

概要

NBD法では電子線が試料中で回折する角度(電子線回折スポット位置)の変化から、格子歪に関する知見を得ることができます。任意の晶帯軸入射方向で、デバイスパターンに合わせた測定が可能です。素子分離領域(LOCOS周辺)のSi基板について測定した結果、熱処理温度・結晶方向によって歪量が異なっていることが確認できました。

データ



素子分離領域の歪分布解析例

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : http://www.mst.or.jp/